

新闻稿

XFAB 0.18um 高压工艺提供嵌入式闪存(eFlash)

XH018 嵌入式闪存(eFlash) 工艺为高阶系统芯片(SoCs)提供业界最具性价比的高压整合方案

2011年7月5日，德国艾尔福特(Erfurt) – X-FAB Silicon Foundries 在 XH018 0.18um 高压工艺上增加高可靠性的嵌入式闪存(eFlash)方案。此方案提供了业界最少的光罩版数，32层，其中包含数字、模拟、高压元件、并闪存，而闪存只要额外2层光罩。对高阶片上混合信号系统芯片(SoCs)，此方案具有极高的性价比，其中的45V高压元件与嵌入式内存，EEPROM、非挥发性随机内存(NVRAM)、嵌入式闪存(eFlash)，更适用于高速微处理器、数字电源、和车用电子。X-FAB 将于2011年7月13日举办一场免费的网络研讨会来讨论此项“简单且可靠的非挥发性内存(NVM) – 0.18um 的嵌入式闪存(eFlash)与嵌入式非挥发性内存(eNVM)”

两种不同的内存模块 – 8K x 32-bit 和 16K x 32bit – 新的 XH018 嵌入式闪存(eFlash)方案易于整合、快速存取，并且比非嵌入式内存更耐用。此方案包含纠错码(ECC)的功能，允许程序在运行的同时修正错误。在1.8V或3.3V工作电压下，提供50nS快速读取，并且不受温度、工作电压和工艺漂移的影响，而且支援低功耗(200uA/MHz)、高温读取(摄氏175度)的特性。

XFAB 总裁 Rudi De Winter 表示：“客户告诉我们，他们要用嵌入式闪存 eFlash 技术作为平台来研发整个系列的产品。有了我们 XH018 嵌入式闪存(eFlash)方案，客户可以非常容易地修改软件来根据应用改变产品的性能与定义。因此，客户只要有一个高可靠性与高整合性的电路架构，就

可以开发整个系列的产品。对于讲求性价比与复杂性的片上系统芯片(SoCs)，XH018 嵌入式闪存(eFlash)方案提供一项完美且包含高压制程的组合。”

XH018 嵌入式闪存(eFlash)方案也结合 X-FAB 已有的嵌入式非挥发性内存(NVM)，包含一次性可编程(OTP)与非挥发性随机内存(NVRAM)。XFAB 更提供编译工具帮助工程师依据自身的需要来定义内存的使用。

XH018 嵌入式非挥发性内存(NVM)的设计套件与 IP 已开放授权并可在 X-FAB 技术中心(X-TIC)下载使用，其中 EEPROM 将于 2011 年第四季度开放授权。而整套的电路模块正在进行综合地测试以通过最后的合格验证。X-FAB 计划于 2012 年年初提供另外不同尺寸的内存及高温的特性数据。

X-FAB 简介

X-FAB 是顶尖的模拟/数字集成电路(混合讯号 IC)的晶圆代工业者。X-FAB 目前全球员工人数约为 2400 名，所拥有代工厂位于德国的艾尔福特(Erfurt)与德勒斯登(Dresden)、美国德州的卢伯克(Lubbock)和马来西亚沙劳越的古晋(Kuching)。代工制程以先进模块化 CMOS 与 BiCMOS 为基础，搭配 1.0 到 0.13 微米技术，涵盖以汽车、通信、消费性产品与工业部门为主的各种应用。相关信息，请上网址：www.xfab.com

X-FAB 联络人

Thomas Hartung
VP Marketing
+49-361-427-6160
thomas.hartung@xfab.com

X-FAB Semiconductor Foundries AG
Haarbergstr. 67
99097 Erfurt, Germany

ThinkBold Corporate Communications
Dagmar Berendes
+1-408-379-2344
dagmar@thinkbold.com

Sarah Miller
+1-231-264-8636
sarah@thinkbold.com